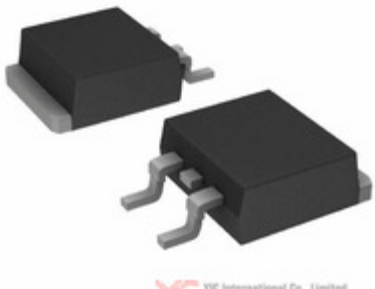


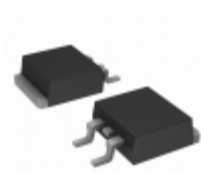


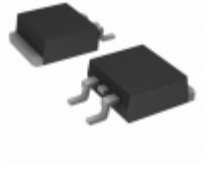



	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R225C7ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 11A TO-263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB65R225C7ATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R225C7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 11A TO-263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 240µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	CoolMOS™ C7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	225 mOhm @ 4.8A, 10V
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	996pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

IPB65R225C7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R225C7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R225C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R225C7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R225C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R190CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 17.5A TO263</p>	 <p>IPB65R190CFDA Infineon IPB65R190CFDA Infineon</p>	 <p>IPB65R280E6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>
 <p>IPB65R190CFDAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R190CFD Infineon Technologies IPB65R190CFD Infineon Technologies</p>	 <p>IPB65R280C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13.8A TO263</p>	 <p>IPB65R190C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R225C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R225C7ATMA1 Datenblatt	IPB65R225C7ATMA1-Datenblätter	IPB65R225C7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R225C7ATMA1
IPB65R225C7ATMA1 Electronic	IPB65R225C7ATMA1-Komponenten	IPB65R225C7ATMA1-Verteiler	IPB65R225C7ATMA1-Bild	IPB65R225C7ATMA1-Teil
IPB65R225C7ATMA1 Preis	IPB65R225C7ATMA1 Hersteller	IPB65R225C7ATMA1 Bild	IPB65R225C7ATMA1 Aktie	IPB65R225C7ATMA1 Inventar
IPB65R225C7ATMA1 Neu	IPB65R225C7ATMA1 Original	IPB65R225C7ATMA1 garantiert	IPB65R225C7ATMA1 RFQ	IPB65R225C7ATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited